(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Bureau international

(43) Date de la publication internationale
10 novembre 2011 (10.11.2011)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2011/138524 A1

(51) Classification internationale des brevets : *H01L 21/66* (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale : PCT/FR2011/000273

(22) Date de dépôt international : 4 mai 2011 (04.05.2011)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
1001958 6 mai 2010 (06.05.2010) FR

(71) Déposant *(pour tous les États désignés sauf US)* : **ALTATECH SEMICONDUCTOR** [FR/FR]; 611, rue Aristide Bergès, F-38330 Montbonnot-Saint-Martin (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants *(pour US seulement)* : **GASTALDO, Philippe** [FR/FR]; 412, Jardins de Bérénice, F-38530 Pontcharra (FR). **PERNOT, Frédéric** [FR/FR]; 25, rue Paviot, F-38120 Saint Egrève (FR). **PIFFARD, Olivier** [FR/FR]; 46, avenue Général Miribel, F-38190 Villard Bonnot (FR).

(74) Mandataires : **PLAÇAIS, Jean-Yves** et al.; Cabinet Netter, 36, avenue Hoche, F-75008 Paris (FR).

(81) États désignés *(sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible)* : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

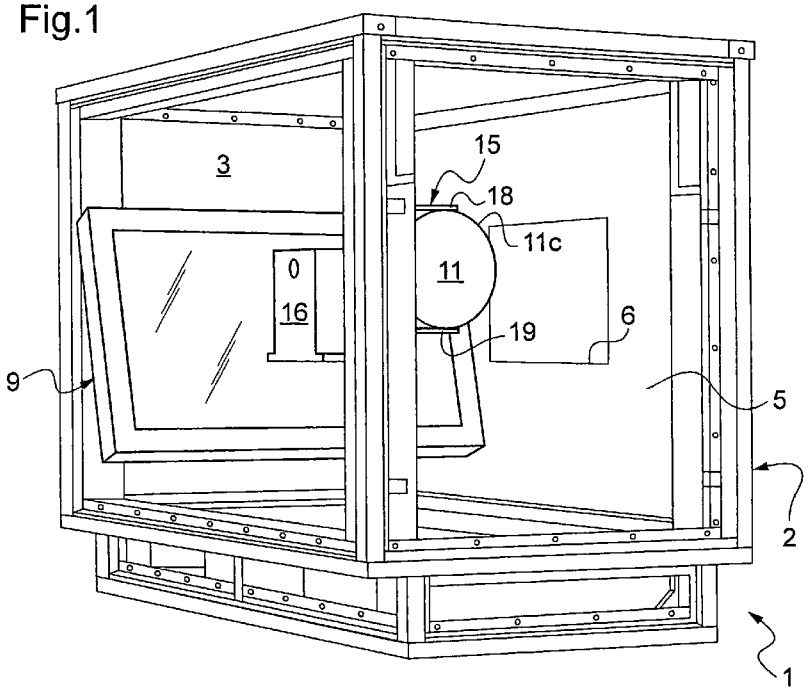
(84) États désignés *(sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible)* : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Suite sur la page suivante]

(54) **Title** : DEVICE AND METHOD FOR INSPECTING MOVING SEMICONDUCTOR WAFERS

(54) **Titre** : DISPOSITIF ET PROCEDE D'INSPECTION DE PLAQUETTES SEMI-CONDUCTRICES EN MOUVEMENT

Fig.1



(57) **Abstract** : Device for inspecting defects in semiconductor wafers, comprising a member for detecting surface defects using variations in the slope of a surface of the wafer, a member for detecting surface defects using variations in the light intensity reflected by a surface of the wafer, at a plurality of points, a member for detecting light intensity scattered by the surface of the wafer, a light source, and a detecting and classifying mechanism connected upstream of said detecting members.

(57) **Abrégé** : Dispositif d'inspection (1) de défauts de plaquettes semiconductrices (11), comprenant un organe de détection de défauts de surface à partir des variations de la pente d'une surface de la plaquette, un organe de détection de défauts de surface à partir des variations de l'intensité lumineuse réfléchie par une surface de la plaquette, en une pluralité de points, un organe de détection de l'intensité lumineuse diffusée par la surface de la plaquette, une source lumineuse (9), et un mécanisme de détection et de classification monté en aval desdits organes de détection.

WO 2011/138524 A1